

Список основных публикаций
Александра Анатольевича Мармалюка

1. Засавицкий И. И., Зубов А. Н., Андреев А. Ю., Багаев Т. А., Горлачук П. В., Ладугин М. А., Падалица А. А., Лобинцов А. В., Сапожников С. М., Мармалюк А. А. Квантовый каскадный лазер на основе гетеропары GaAs/Al_{0.45}Ga_{0.55}As, полученный методом МОС-гидридной эпитаксии // Квантовая электроника. 2016. - Т. 46. №5. - С. 447-450.
2. Андронов А. А., Додин Е. П., Зинченко Д. И., Ноздрин Ю. Н., Ладугин М. А., Мармалюк А. А., Падалица А. А., Беляков В. А., Ладенков И. В., Фефелов А. Г. Стимулированные излучения при переходах между лестницами Ванье–Штарка в полупроводниковых сверхрешетках // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 2015. - Т. 102. №4. - С. 235-239.
3. Костин Ю. О., Ладугин М. А., Лобинцов А. А., Мармалюк А. А., Чаморовский А. Ю., Шраменко М. В., Якубович С. Д. Полупроводниковые лазеры с полосой непрерывной перестройки более 100 нм в "ближайшем" ИК диапазоне спектра // Квантовая электроника. 2015. - Т. 45. №8. - С. 697-700.
4. Гамов Н. А., Жданова Е. В., Зверев М. М., Перегудов Д. В., Студенов В. Б., Мазалов А. В., Курешов В. А., Сабитов Д. Р., Падалица А. А., Мармалюк А. А. Импульсный лазер с накачкой электронным пучком на основе квантово-размерной гетероструктуры AlGaIn/InGaIn/GaN // Квантовая электроника. 2015. - Т. 45. №7. - С. 601-603.
5. Коняев В.П., Мармалюк А.А., Ладугин М.А., Багаев Т.А., Зверков М.В., Кричевский В.В., Падалица А.А., Сапожников С.М., Симаков В.А. Решетки лазерных диодов с повышенной мощностью и яркостью импульсного излучения на основе эпитаксиально-интегрированных гетероструктур // Физика и Техника Полупроводников. 2014. - Т. 48. №1. - С. 104-108.
6. Горлачук П.В., Рябоштан Ю.Л., Мармалюк А.А., Курносков В.Д., Курносков К.В., Журавлева О.В., Романцевич В.И., Чернов Р.В., Иванов А.В., Симаков В.А. Мощные импульсные лазерные излучатели спектрального диапазона 1.5–1.6 мкм // Физика и Техника Полупроводников. 2014. - Т. 48. №1. - С. 100-103.
7. Андреева Е. В., Ильченко С. Н., Ладугин М. А., Лобинцов А. А., Мармалюк А. А., Шраменко М. В., Якубович С. Д. Широкополосные полупроводниковые оптические усилители спектрального диапазона 750 – 1100 нм // Квантовая электроника. 2013. - Т. 43. №11. - С. 944-998.
8. Мармалюк А. А., Ладугин М. А., Андреев А. Ю., Телегин К. Ю., Яроцкая И. В., Мешков А. С., Коняев В. П., Сапожников С. М., Лебедева Е. И., Симаков В. А. Линейки лазерных

- диодов на основе гетероструктур AlGaAs/GaAs ($\lambda = 808$ нм) с повышенной температурной стабильностью // Квантовая электроника. 2013. - Т. 43. №10. - С. 895-897.
9. Горлачук П. В., Рябоштан Ю. Л., Ладугин М. А., Падалица А. А., Мармалюк А. А., Курносов В. Д., Курносов К. В., Журавлева О. В., Романцевич В. И., Чернов Р. В., Иванов А. В., Симаков В. А. Линейки импульсных лазерных диодов спектрального диапазона 1.5 – 1.6 мкм на основе эпитаксиально-интегрированных гетероструктур AlGaInAs/InP // Квантовая электроника. 2013. - Т. 43. №9. - С. 822-823.
 10. Горлачук П. В., Рябоштан Ю. Л., Ладугин М. А., Падалица А. А., Мармалюк А. А., Курносов В. Д., Курносов К. В., Журавлева О. В., Романцевич В. И., Чернов Р. В., Иванов А. В., Симаков В. А. Мощные импульсные лазерные диоды спектрального диапазона 1.5 – 1.6 мкм // Квантовая электроника. 2013. - Т. 43. №9. - С. 819-821.
 11. Андреева Е. В., Ильиченко С. Н., Костин Ю. О., Ладугин М. А., Лапин П. И., Мармалюк А. А., Якубович С. Д. Широкополосные суперлюминесцентные диоды диапазона 800 – 900 нм с колоколообразной формой спектра // Квантовая электроника. 2013. - Т. 43. №8. - С. 751-756.
 12. Дегтярева Н. С., Кондаков С. А., Микаелян Г. Т., Горлачук П. В., Ладугин М. А., Мармалюк А. А., Рябоштан Ю. Л., Яроцкая И. В. Непрерывные мощные лазерные линейки спектрального диапазона 750 – 790 нм // Квантовая электроника. 2013. - Т. 43. №6. - С. 509-511.
 13. Ладугин М. А., Коваль Ю. П., Мармалюк А. А., Петровский В. А., Багаев Т. А., Андреев А. Ю., Падалица А. А., Симаков В. А. Мощные импульсные лазерные излучатели спектрального диапазона 850 – 870 нм на основе гетероструктур с узкими и широкими волноводами // Квантовая электроника. 2013. - Т. 43. №5. - С. 407-409.
 14. Ильченко С. Н., Ладугин М. А., Мармалюк А. А., Якубович С. Д. Суперлюминесцентные диоды "ближайшего" ИК диапазона с шириной спектра 100 нм // Квантовая электроника. 2012. - Т. 42. №11. - С. 961-963.
 15. Мармалюк А. А., Ладугин М. А., Яроцкая И. В., Панарин В. А., Микаелян Г. Т. Линейки лазерных диодов на основе гетероструктур AlGaPAs/GaAs с компенсацией механических напряжений // Квантовая электроника. 2012. - Т. 42. №1. - С. 15-17.